

## Elektrische Eigenschaften Electrical properties

Höchstzulässige Werte	Maximum rated values				
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-SpitzenSperrspannung	repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\max}$	$V_{DRM}, V_{RRM}$	2800, 3000	V
Vorwärts-Stoßspitzen-Sperrspannung	non repetitive peak forward off-state voltage	$t_{vj} = -40^\circ\text{C} \dots t_{vj\max}$	$V_{DSM} = V_{DRM}$		
Rückwärts-Stoßspitzen-Sperrspannung	non repetitive peak reverse voltage	$t_{vj} = +25^\circ\text{C} \dots t_{vj\max}$	$V_{RSM} = V_{RRM}$	+ 100	V
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current		$I_{TRMSM}$	1700	A
Dauergrenzstrom	average on-state current	$t_C = 85^\circ\text{C}$	$I_{TAVM}$	690	A
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	$t_C = 54^\circ\text{C}$	$I_{TSM}$	1060	A
Grenzlastintegral	$I^2t$ -value	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$	$I^2t$	15	kA
Kritische Stromsteilheit	critical rate of rise of on-state current	$t_{vj} = t_{vj\max}, t_p = 10 \text{ ms}$		14	kA
Kritische Spannungssteilheit	critical rate of rise of off-state voltage	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, t_p = 10 \text{ ms}$		1125	kA <sup>2</sup> s
		$t_{vj} = t_{vj\max}, t_p = 10 \text{ ms}$		960	kA <sup>2</sup> s
		$V_D \leq 67\% V_{DRM}, f = 50 \text{ Hz}$	$(di/dt)_{cr}$	200	A/ $\mu$ s
		$i_{GM} = 1,5 \text{ A}, di_G/dt = 2 \text{ A}/\mu\text{s}$			
		$t_{vj} = t_{vj\max}, V_D = 67\% V_{DRM}$	$(dv/dt)_{cr}$	1000	V/ $\mu$ s
				1)	
				2)	
			$N:$	50	
					V/ $\mu$ s

## Charakteristische Werte Characteristic values

Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj\max}, i_T = 3200 \text{ A}$	$v_T$	max.	3,2	V
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj\max}$	$V_{T(TO)}$		1,5	v
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vj} = t_{vj\max}$	$r_T$		0,5	m $\Omega$
Zündstrom	gate trigger current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	$I_{GT}$	max.	300	mA
Zündspannung	gate trigger voltage	$t, = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}$	$V_{GT}$	max.	2	v
Nicht zündender Steuerstrom	gate non-trigger current	$t, = t_{vj\max}, V_D = 6 \text{ V}$	$I_{GD}$	max.	40	mA
Nicht zündende Steuerspannung	gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj\max}, V_D = 0,5 V_{DRM}$	$V_{GD}$	max.	0,3	v
Haltestrom	holding current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_A = 5 \Omega$	$I_H$	max.	400	mA
Einraststrom	latching current	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_D = 6 \text{ V}, R_{GK} \geq 10 \Omega$	$I_L$	max.	2	A
Vorwärts- u. Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse Currents	$i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}, t_g = 20 \text{ ps}$	$i_D, i_R$	max.	200	mA
Zündverzug	gate controlled delay time	$t_{vj} = t_{vj\max}, V_D = V_{DRM}, V_R = V_{RRM}$	$t_{gd}$	max.	2,3	$\mu$ s
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	$t_{vj} = 25^\circ\text{C}, i_{GM} = 1 \text{ A}, di_G/dt = 1 \text{ A}/\mu\text{s}$ siehe Techn. Erl./see Techn. Inf.	$t_q$	1:	120	$\mu$ s

## 'hermische Eigenschaften

## Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand für beidseitige Kühlung	thermal resistance, junction to case for two-sided cooling	$\Theta = 180'' \text{ el, sin DC}$	$R_{thJC}$	max.	0,0215 $^\circ\text{C}/\text{W}$
Übergangswärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	beidseitig/two-sided einseitig/one-sided	$R_{thCK}$	max.	0,005 $^\circ\text{C}/\text{W}$
Höchstzul. Sperrschiichttemperatur	max. junction temperature			max.	0,010 $^\circ\text{C}/\text{W}$
Betriebstemperatur	Operating temperature				120 $^\circ\text{C}$
Lagertemperatur	storage temperature				$-40 \dots + 120^\circ\text{C}$
					$t_{stg}$
					$-40 \dots + 150^\circ\text{C}$

## Mechanische Eigenschaften

## Mechanical properties

Si-Element mit Druckkontakt	Si-pellet with pressure contact		$F$	13,5 ... 24 kN
Anpreßkraft	Clamping force		$G$	typ. 550 g
Gewicht	weight			25 mm
Kriechstrecke	Creepage distance			C
Feuchteklaasse	humidity classification	DIN 40040		50 m/s <sup>2</sup>
Schwingfestigkeit	Vibration resistance	f = 50 Hz		
Maßbild	outline	DIN 41814-151A4		Seite/page 155

1) Werte nach DIN IEC 747-6 (ohne vorausgehende Kommutierung)/Values to DIN IEC 747-6 (without prior commutation)

2) Unmittelbar nach der Freiwerdezeit, vgl. Meßbedingungen für t<sub>q</sub>/Immediately after circuit commutated turn-off time, see Parameters t<sub>q</sub>